## **- 保教师** 考场教室 座位号

中

……线…………以………内……啊……给……给

A A |

系统

## 电子科技大学 2020-2021 学年第二学期期中考试卷

考试科目: <u>电磁场与电磁波 B</u>考试形式: <u>闭卷</u>考试日期: <u>2021</u>年<u>5</u>月<u>15</u>日 本试卷由三部分构成,共<u>八</u>页。考试时长: <u>120</u>分钟 注: <u>可使用非存储功能的简易计算器</u>

题号	_	11	11.1	四	五.	六	七	八	合计
得分									

附录: 
$$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \text{ F/m} \qquad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$

得分一、填空题(共20分,每空1分)

- 1. 线性、各向同性媒质的本构关系为:  $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ ,  $\vec{B} = \mu \vec{H}$ ,  $\vec{J} = \sigma \vec{E}$
- 2. 在时变电磁场, $\nabla \times \vec{E} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$  ,表明<u>时变磁场</u>产生电场; $\nabla \cdot \vec{B} = 0$  ,表明时变磁场是<u>无散</u>场。
- 3. 电荷体密度的单位是<u>库伦/米³(C/m³)</u>,面电流密度矢量的单位是<u>安/米(A/m)</u>。
- 4. 在半径为 a,介电系数  $\varepsilon = 2\varepsilon_0$  的球形电介质内,已知极化强度矢量  $\vec{P} = -\vec{e}_r \frac{r}{8\pi a^3}$  ,则极化电荷体密度为 $\frac{3}{8\pi a^3}$  ,极化电荷面密度为 $\frac{1}{8\pi a^2}$  ,极化电荷总量为 $\frac{0}{8\pi a^3}$  。
  - 5. 已知导体材料的磁导率为 $\mu$ ,介电常数为 $\varepsilon$ ,以该材料制成的半径为 $\alpha$ 的长直导线的单位长

度内自感为 $\frac{\mu}{8\pi}$ ,当导线半径增大时,单位长度导线的内自感将 $\frac{\mu}{2\pi}$ 不变。(填"变大、变小或不变")

- 6. 在理想导体表面存在磁场强度  $\vec{H}$  和电位移矢量  $\vec{D}$  , 理想导体的外法线单位矢量为  $\vec{e}_n$  , 则理 想导体外表面的传导电流面密度 $\vec{J}_{S} = \underline{\vec{e}_{n}} \times \underline{\vec{H}}$ ,自由电荷面密度 $\rho_{S} = \underline{\vec{e}_{n}} \cdot \underline{\vec{D}}$ 。
- 7. 已知体积 V 内的静电荷体密度为  $\rho$  ,在空间中形成的电位分布为  $\varphi$  、电场分布为  $\vec{E}$  和  $\vec{D}$  ,则空 间的静电能量密度为 $\frac{1}{2} \cdot \vec{D}$ , 空间的总静电能量为 $\frac{1}{2} \int_{V} \rho \varphi dV$ 。
- 8. 电流连续性方程的微分形式是  $\nabla \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$  , 其物理意义是 电荷守

得分 二、选择题(共20分,每空2分)

- 1、 在无界空间中,任意矢量场可表示为如下形式( C )。

  - A.  $\vec{F}(\vec{r}) = \nabla \cdot \vec{A}(\vec{r}) + \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$  B.  $\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla u(\vec{r}) + \nabla \cdot \vec{A}(\vec{r})$
- C.  $\vec{F}(\vec{r}) = -\nabla u(\vec{r}) + \nabla \times \vec{A}(\vec{r})$
- 2、自由空间的电位函数  $\varphi = 2x^2y 5z + 4xy^2z$  ,则点 P(1,1,1) 处的电场强度为(B)。
  - A.  $\vec{E} = -8\vec{e}_x 10\vec{e}_y + 5\vec{e}_z$  B.  $\vec{E} = -8\vec{e}_x 10\vec{e}_y + \vec{e}_z$ 

    - C.  $\vec{E} = -8\vec{e}_x 10\vec{e}_y \vec{e}_z$
- 3、关于电场强度和电位下列说法正确的是( C )
- A. 电场强度越大的地方电位一定越高
- B. 电场强度为零的地方电位一定为零
- C. 电场强度相同的点电位不一定相同
- 4、关于磁场强度、磁感应强度及磁化强度,下列公式始终成立的是:( B

A. 
$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

A. 
$$\vec{B}=\mu\vec{H}$$
 B.  $\vec{B}=\mu_0(\vec{H}+\vec{M})$  C.  $\vec{M}=\chi_m\vec{H}$ 

C. 
$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

- 5、关于关于恒定磁场中的矢量磁位,下面叙述不正确的是(
  - A. 矢量磁位的引入是因为磁感应强度的散度处处为零;
  - B. 矢量磁位满足矢量拉普拉斯方程;
- C. 采用库仑规范是为了唯一确定矢量磁位;
- 6、安培环路定理 $\oint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$  中,闭合回路上任一点的磁感应强度 $\vec{B}$ 是( C
  - A. 闭合回路路内的电流产生
- B. 闭合回路外的电流产生
- C. 闭合回路内、外的电流共同产生
- $\stackrel{:}{\mathbb{R}}$ 7、平行板电容器两极板面积为 S、板间距为 d,板间外加电压为  $U_0$ 。当板间介质为空气时,其电 容为  $C_0$ 、静电能量为  $We_0$ 。若将相对介电系数为  $\varepsilon$  的均匀介质充满两极板之间,则电容和静 电能量改变为(A

A. 
$$C = \varepsilon_r C_0, W_e = \varepsilon_r W_{e0}$$

$$A. \quad C = \varepsilon_r C_0, W_e = \varepsilon_r W_{e0} \qquad \qquad B. \quad C = \varepsilon_r C_0, W_e = \frac{W_{e0}}{\varepsilon_r} \qquad \quad C. \quad C = \frac{C_0}{\varepsilon_r}, W_e = \frac{W_{e0}}{\varepsilon_r}$$

C. 
$$C = \frac{C_0}{\varepsilon}, W_e = \frac{W_{e0}}{\varepsilon}$$

8、介电常数和电导率分别为 $\mathcal{E}_1,\mathcal{E}_2$ 和 $\sigma_1,\sigma_2$ 的两种导电媒质,当其中通有恒定电流时,则分界面 上 的电荷面密度为( B

A. 
$$\rho_s = 0$$

B. 
$$\rho_s = J_{2n}(\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\sigma_1})$$
 C.  $\rho_s = J_{1n}(\frac{\sigma_2}{\varepsilon_2} - \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1})$ 

C. 
$$\rho_s = J_{1n} \left( \frac{\sigma_2}{\varepsilon_2} - \frac{\sigma_1}{\varepsilon_1} \right)$$

- 9、已知在电导率  $\sigma=4.0~\mathrm{S/m}$ 、介电常数  $\varepsilon=80\varepsilon_0$  的海水中,电场强度
- $E = 20\sin(10^9\pi t) \text{ V/m}$  ,则位移电流密度为  $(\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \text{ F/m})$  ( C )。

A. 
$$J_d = 80 \sin(10^9 \pi t) \text{ A/m}^2$$

B. 
$$J_d = 2 \times 10^{10} \cos(10^9 \pi t) \text{ A/m}^2$$

C. 
$$J_d = \frac{400}{9} \cos(10^9 \pi t) \text{ A/m}^2$$

- 10、关于电流回路所储存的磁场能量,下面叙述正确的是( B
  - A. 电流回路所储存的磁场能量只存在于电流回路中;
  - B. 电流回路所储存的磁场能量与回路的电感有关;
  - C. 电流回路所储存的磁场能量与回路所处媒质无关。

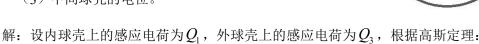
得 分

## 三、计算题(共60分)

1、无源媒质中电场强度  $\vec{E}=\vec{e}_y$  45  $\sin(10^9t)\cos(5z)$  V/m,  $\mu=\mu_0$ 。利用麦克斯韦方程求磁场强度  $\vec{H}$  和媒质的相对介电常数  $\varepsilon_r$  (15 分)。

………………密………封………线……以……以……内………冷………答……那……无……无……救

- **2、**三个同心金属球壳形成一静电系统,内球壳半径为 $R_1$ ,中间球壳半径为 $R_2$ ,外球壳半径为 $R_3$ ,在球壳之间的介质为自由空间, 而内、外球壳皆接地,在中间球壳上有均匀分布面电荷,总电荷量为 $Q_2$ ,试求:
  - (1) 在内球壳上感应的电荷值 $Q_1$ ;
  - (2) 在外球壳上感应的电荷值 $Q_3$ ;
  - (3) 中间球壳的电位。



$$R_{\rm l} < r < R_{\rm 2}$$
时, $\vec{E}_{\rm l} = \frac{Q_{\rm l}}{4\pi \varepsilon_{\rm 0} r^2} \vec{e}_r$  (2分)

$$R_2 < r < R_3$$
 时,  $\vec{E}_2 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$  (2分)

$$R_3 < r$$
时,  $\vec{E}_3 = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$  (2分)

又因为  $r=R_3$  时, 球壳接地, 静电屏蔽

$$\vec{E}_3 = 0 \Rightarrow Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$$

中间导体球的电位

$$\varphi|_{r=R_2} = \int_{R_2}^{R_1} \vec{E}_1 \cdot (-d\vec{r}) = \frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0} (\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1})$$
 (2  $\%$ )

$$\varphi|_{r=R_2} = \int_{R_2}^{R_3} \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\varepsilon_0} (\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3})$$
 (2 \(\frac{1}{2}\))

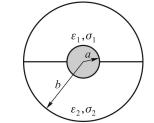
两式相比,可得 
$$(Q_1+Q_2)(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_3})=Q_1(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_1})$$
 (1分)

$$Q_{1} = Q_{2} \frac{R_{1}(R_{3} - R_{2})}{R_{2}(R_{1} - R_{3})} \qquad Q_{3} = Q_{2} - Q_{1} = Q_{2} \frac{R_{3}(R_{2} - R_{1})}{R_{2}(R_{1} - R_{3})}$$
(2 \(\frac{1}{2}\)

$$\varphi\big|_{r=R_2} = \int_{R_2}^{R_1} \vec{E}_1 \cdot (-d\vec{r}) = \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{(R_3 - R_2)(R_1 - R_2)}{R_2^2(R_1 - R_3)}$$
(1 \(\frac{\partial}{2}\)

- **3** 如图所示,内、外导体半径分别为 a 和 b 的同轴电缆,内外导体之间以过轴线的平面为分界面,一半填充电容率为 $\epsilon_1$ 、电导率为 $\sigma_1$  的媒质,一半填充电容率为 $\epsilon_2$ 、电导率为 $\sigma_2$  的媒质,试求:
  - (1) 该电缆单位长度的电容和漏电导:
  - (2) 当外导体接地,内导体上加电压 U 时,单位长度电缆内储存的电场能量和损耗的功率。

解:设内外导体间单位长度的漏电流为 *I*,电场沿径向轴对称分布,由于在媒质分界面上电场处于切向,应满足切向连续,因此有:



$$E_1 = E_2 = E \qquad (1 \%)$$

由
$$\vec{J}_1 = \sigma \vec{E}_1$$
  $\vec{J}_2 = \sigma \vec{E}_2$  得

$$I = \pi \rho (J_1 + J_2) = \pi \rho (\sigma_1 + \sigma_2) E \qquad (2 \%)$$

$$\vec{E} = \frac{I}{\pi \rho (\sigma_1 + \sigma_2)} \vec{e}_{\rho} \tag{2 \%}$$

内外导体间的电压为 
$$U = \int_a^b \frac{I}{\pi \rho(\sigma_1 + \sigma_2)} d\rho = \frac{I}{\pi(\sigma_1 + \sigma_2)} \ln \frac{b}{a}$$
 (2分)

单位长度的漏电导为

$$G = \frac{I}{U} = \frac{\pi(\sigma_1 + \sigma_2)}{\ln \frac{b}{a}}$$
 (2 \(\frac{\frac{1}{2}}{2}\))

由静电比拟关系可得单位长度的电容为

$$C = \frac{\pi(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}{\ln \frac{b}{a}}$$
 (2 \(\frac{\phi}{a}\))

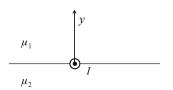
单位长度电缆储存的电场能量为
$$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{\pi(\sigma_1 + \sigma_2)}{\ln\frac{b}{a}}U^2$$
 (2分)

单位长度电缆损耗的功率为

$$P = \int_{a}^{b} (\sigma_{1}E^{2} + \sigma_{2}E^{2})\pi\rho d\rho = \frac{\pi(\sigma_{1} + \sigma_{2})}{\ln\frac{b}{a}}U^{2}$$
(2 分)

**4**、一根无限长的直线电流通流 I,位于两种半无限大磁介质的分界面内,如图所示,如图所示,在 y>0 区域内,介质的磁导率为  $\mu_1$  ,在 y<0 区域内,介质的磁导率为  $\mu_2$  。试求:

- (1) 两介质中的磁感应强度、磁场强度、磁化强度;
- (2) 电流 I 处的磁化电流及分界面处的磁化面电流的分布。



解: 以电流为 z 轴建立圆柱坐标系,磁感应强度和磁场强度是轴对称的平行平面场,方向为  $\vec{e}_{\varphi}$  在分界面处仅有法向分量,满足边界条件

$$B_{1n} = B_{2n} = B \qquad (2 \, \text{fr})$$

利用安培环路定律,有

$$\oint_{c} \vec{H} \cdot d\vec{l} = H_{1}\pi\rho + H_{2}\pi\rho = I \qquad (2 \ \%)$$

$$\frac{B}{\mu_1}\pi\rho + \frac{B}{\mu_2}\pi\rho = I \quad (2 \ \%)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_1 \mu_2 I}{(\mu_1 + \mu_2)\pi\rho} \vec{e}_{\varphi} \qquad (1 \ \%)$$

$$\vec{H}_{1} = \frac{\mu_{2}I}{(\mu_{1} + \mu_{2})\pi\rho} \vec{e}_{\varphi} \quad \vec{H}_{2} = \frac{\mu_{1}I}{(\mu_{1} + \mu_{2})\pi\rho} \vec{e}_{\varphi} \qquad (2 \%)$$

$$\vec{M}_{1} = (\frac{\mu_{1}}{\mu_{0}} - 1) \frac{\mu_{2}I}{(\mu_{1} + \mu_{2})\pi\rho} \vec{e}_{\varphi} \quad \vec{M}_{2} = (\frac{\mu_{2}}{\mu_{0}} - 1) \frac{\mu_{1}I}{(\mu_{1} + \mu_{2})\pi\rho} \vec{e}_{\varphi} \quad (2 \%)$$

分界面处的磁化强度方向与分界面法线方向平行, 故

$$\vec{J}_{ms} = 0 \qquad (2 \, \text{\beta})$$

利用推广的安培环路定理

$$\oint_{c} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_{0}(I + I_{m})$$

$$\mu_{0}(I + I_{m}) = 2\pi\rho \frac{\mu_{1}\mu_{2}I}{(\mu_{1} + \mu_{2})\pi\rho} \Rightarrow I_{m} = \left[\frac{2\mu_{1}\mu_{2}}{(\mu_{1} + \mu_{2})\mu_{0}} - 1\right]I$$
第 7 页